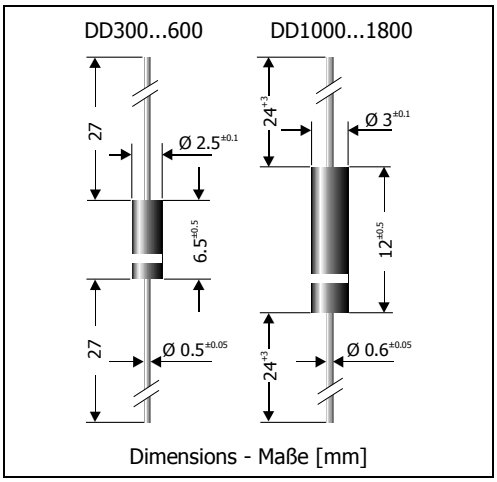
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

DD300 ... DD1800

Fast Switching High Voltage Silicon Rectifier Diodes
Schnelle Silizium-Hochspannungs-Gleichrichterdioden

Version 2007-03-16



Dimensions - Maße [mm]

Nominal current Nennstrom		20 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung		3 ... 18 kV
Plastic case Kunststoffgehäuse	DD300...DD600 DD1000...DD1800	Ø 2.5 x 6.5 [mm] Ø 3 x 12 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	DD300...DD600 DD1000...DD1800	0.3 g 0.7 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack

Maximum ratings **Grenzwerte**

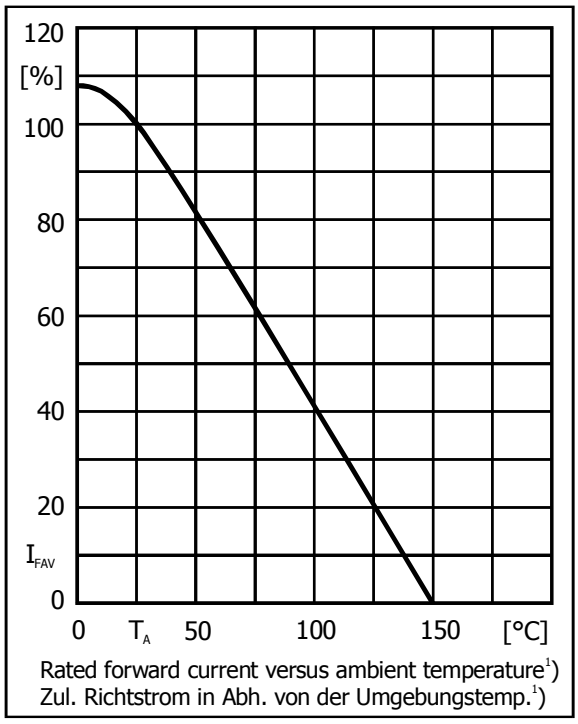
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DD300	3000	3000
DD600	6000	6000
DD1000	10000	10000
DD1200	12000	12000
DD1400	14000	14000
DD1600	16000	16000
DD1800	18000	18000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	T_A = 25°C	I_{FAV}	20 mA [1])
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I_{FRM}	300 mA [1])
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	T_A = 25°C	I_{FSM}	3 A [1])
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-50...+150°C -50...+150°C

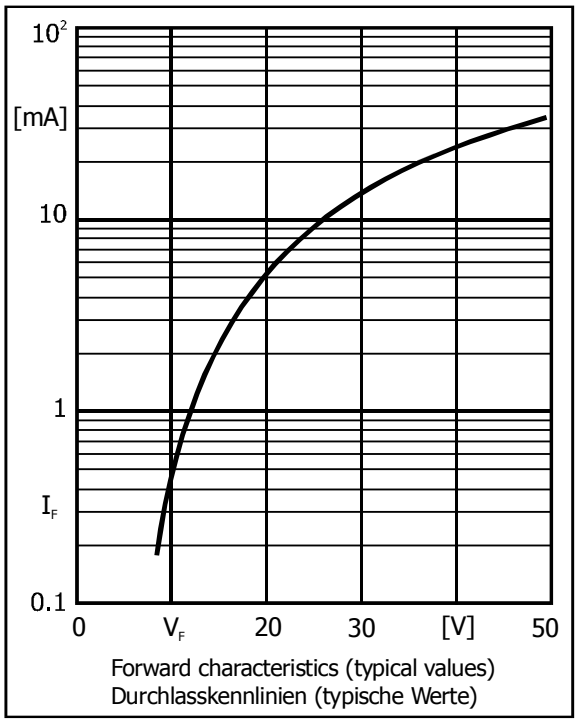
1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

© Diotec Semiconductor AG

Characteristics			**Kennwerte**
Forward voltage Durchlass-Spannung	T_j = 25°C I_F = 10 mA	V_F	< 40 V
Leakage current Sperrstrom	T_j = 25°C $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 5 µA
Reverse recovery time Sperrverzug	I_F = 10 mA through/über I_R = 10 mA to I_R = 1 mA	t_{rr}	< 150 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 60 K/W [1])



Rated forward current versus ambient temperature[1])
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.[1])



Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

© Diotec Semiconductor AG